



晶圆级单层二硫化钼膜及其制备方法

专利名称: 晶圆级单层二硫化钼膜及其制备方法
专利类别: 发明
申请号: 2016110220967
第一发明人: 张广宇
其它发明人: 余画;杨蓉;时东霞
专利授权日期: 2019-11-05

[关闭窗口](#)

